

DirectFET[®] *plus*パワーMOSFETが
効率を最大2%改善

DirectFET[®] *plus*の特徴

- 業界をリードする高性能
 - 低いオン抵抗とゲート抵抗
 - 極めて低いパッケージ抵抗とインダクタンス
 - ショットキ・ダイオードを集積
 - 優れた熱特性
- DirectFETの優れた信頼性
 - 業界最低の不良率（0.8PPM以下）
- 従来のDirectFET製品と同一のフットプリント



DC-DCコンバータのスイッチング用途に 新標準の効率を

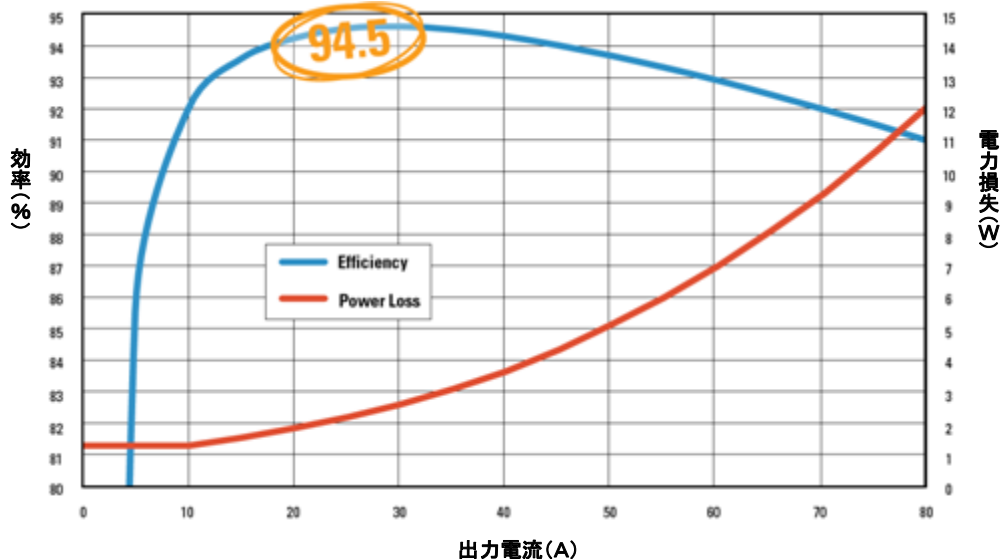
DirectFET[®] *plus*パワーMOSFETは、インターナショナル・レクティファイアー（IR）社の新世代のMOSFETチップを搭載しており、次世代のサーバーやデスクトップPC、ノートPCなどの12V入力の同期整流用途向けに高効率を提供します。

DirectFET[®] *plus*の最初の製品であるIRF6811とIRF6894は、当社従来品に比べて、オン抵抗とゲート電荷を低減し、効率を最大2%改善できます。さらに、ゲート抵抗が非常に小さいため、DC-DCコンバータのスイッチング損失を最小化でき、さらに効率を改善できます。

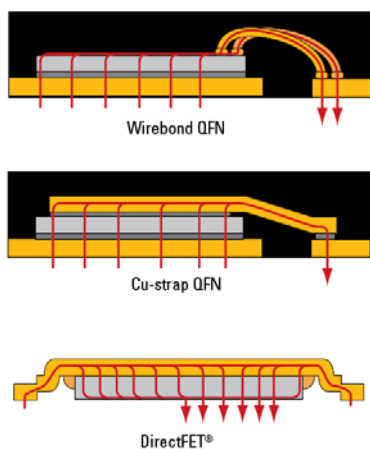


業界最高の性能

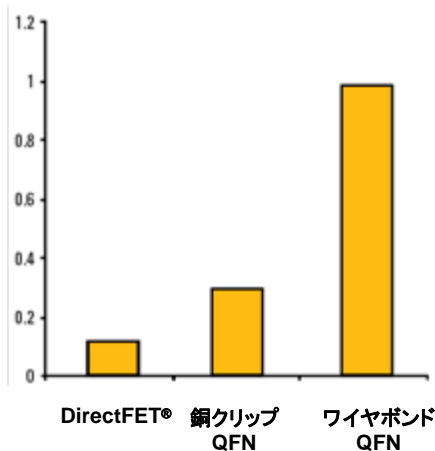
IRF6811とIRF6894を使用した場合の効率
 条件: 12Vin、1.5Vout、300kHz、260nH、25°C、400LFM、ヒートシンクなし



低オン抵抗を可能にするDirectFET® plus



ダイ・フリー・パッケージの抵抗値



型番	耐圧	オン抵抗 (typ. @10V)	オン抵抗 (typ. @4.5V)	ゲート・ソース間電圧	ゲート電荷 (typ.)	ゲート・ドレイン間電荷 (typ.)	パッケージの種類
IRF6811SPBF	25V	2.8mΩ	4.1mΩ	±16V	11nC	4.2nC	SQ
IRF6894MPBF	25V	0.9mΩ	1.3mΩ	±16V	29nC	10nC	MX

DirectFET®はインターナショナル・レクティファイアー社の登録商標です。